

## Quiz 4 - Arquitectura de computadores Carlos Andres Delgado S, Ing \* 30 de Octubre de 2017

Nombre: \_\_ Código: \_

- 1. [20 puntos] Afirmación: La memoria estática (SRAM) es más rápida que la dinámica (DRAM) Razón: debido a que la celda de memoria de la SRAM está compuesta por un condensador y un transistor. Elija una opción:
  - a) Afirmación y razón verdaderas
- (b) Afirmación verdadera y razón falsa
  - c) Afirmación falsa y razón verdadera
- d) Afirmación v razón falsa

Explique las razones de su elección:

## La SRAM está compuesta por un arreglo de 6 transistores

- 2. [20 puntos] Afirmación: La memoria (DRAM) requiere refresco cada vez que se lee un dato Razón: debido a que la celda de memoria está compuesta por un conjunto de transistores. Elija una opción:
  - a) Afirmación y razón verdaderas
- b) Afirmación verdadera y razón falsa
  - c) Afirmación falsa y razón verdadera
  - d) Afirmación y razón falsa

Explique las razones de su elección:

## La DRAM está compuesta por un condensador y un transistor. Además, el condensador es la razón del refresco

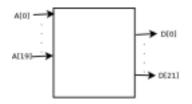
- 3. [20 puntos] Afirmación: Utilizar un bit al final de la cadena, el cual es 1 si se tiene un número impar de 1's en la cadena y 0 en otro caso, es una técnica de corrección de errores Razón: que se requiere para garantizar un refresco correcto en la memoria
  - a) Afirmación y razón verdaderas
- b) Afirmación verdadera y razón falsa
  - c) Afirmación falsa y razón verdadera
- carlos.andres.delgado@correounivalle.edu.co

d) Afirmación y razón falsa

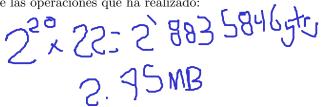
Explique las razones de su elección:

El refresco es una operación de la DRAM y la corrección se realiza en la comunicación (viajan en el bus)

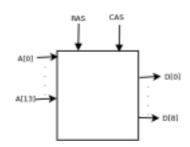
4. [20 puntos] Indique la capacidad de memoria de:



Indique las operaciones que ha realizado:



5. [20 puntos] Indique la capacidad de memoria de:



Indique las operaciones que ha realizado:

